水素による超多量空孔生成がもたらすもの(Ⅱ)

説

~水素誘起欠陥構造と拡散促進効果~

(前稿 (I) からの続き)

- 目次 (I) 1·1 はじめに
 - 1・2 水素と空孔の相互作用
 - 1.3 超多量空孔の生成

2·1 金属-水素-空孔3元系の統計熱力学

超多量空孔生成の過程は、水素だけでなく多量の空孔まで が互いに相互作用しながら出入りするという、これまでに経 験したことのない問題である.この系の性質は深井・杉本の 統計熱力学的理論によって明らかにされた⁽¹⁾.理論による と、この開いた系の振る舞いは水素濃度、温度、空孔-水素 の束縛エネルギーに依存して複雑に変化するが、空孔濃度が 高くなると空孔間で長距離に働く弾性相互作用のために、空 孔濃度が比較的高い相と低い相に分離するという特徴的な現 象が起こる.これは Pd-H系で水素原子間の弾性相互作用 によって起こるスピノーダル分解の空孔版と言ってよい.こ こでは理論の骨子だけを説明するので、詳細は原論文を参照 してほしい.

まず,理論に入る前に,超多量空孔生成の実験から得られ た結果をまとめておこう.

実験結果を概観してみると,導入される空孔の濃度は金属 によって大きく異なっている.一般に fcc 金属では大きく, とくに γ-Fe, Co, Ni では約30 at%に達している. Pd では, やや小さい(~10 at%). Bcc 金属では 1~2 桁小さい. こう して空孔濃度が著しく高いもの(≥10 at%)と比較的低いも の(0.1-1 at%)に 2 分されているように見える.

この傾向はエネルギーにも反映されていて, γ-Fe, Co, Ni では空孔生成エネルギーと空孔-水素の束縛エネルギー(表



深

井

有*

図2·1 高温・高水素圧で観察された Niの格子定数の経時変化を温度の関数として示したもの⁽¹⁾.
 ○純 Ni a₀, Δ水素化直後 a(0), ■水素化から長時間経過したとき a(∞). (図1·6参照).

1·1)から見積もった空孔-水素クラスターの生成エネルギー がほとんど0となるのに対して, Pd, α-Fe, Nb での実験値 0.7, 1.0, 0.3 eV は比較的大きな値をもっている.

そこで、本稿では、超多量空孔生成が最も顕著に現れる y-Fe, Co, Ni とくに Ni を中心に考えていくことにする.

高温・高水素圧に保持した Ni 試料中に水素と空孔が導入 される過程(図1・6)を見ると、格子定数は純 Ni の値 a_0 から H 原子の侵入固溶によって短時間にa(0)まで増加し、その 後、空孔が導入されるにつれて数時間にわたって $a(\infty)$ まで 減少する. $a(\infty)$ は a_0 より僅かに大きい. このような測定を さまざまな温度と水素圧(T, $p_{\rm H}$)について行い、得られた格 子定数を温度の関数として示したものが図2・1である. 純 Ni の格子定数 a_0 は温度上昇とともに熱膨張により僅かに増大

* 中央大学名誉教授,高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所協力研究員,東京大学生産技術研究所研究員(〒191-0033 東京都日野市百草897-7) Some Consequences of Hydrogen-induced Superabundant Vacancy Formation in Metals (II) ~Hydrogen-induced Defect Structures and

Diffusion Enhancement~; Yuh Fukai (Professor Emeritus, Chuo University, Tokyo) Keywords; *M-H-vacancy ternary system, statistical thermodynamics, H-induced enhancement of M-atom diffusion, superabundant vacancy formation in electrodeposited metals, diffusion enhancement in electrodeposited metals 2010年12月20日受理* している. (実験値のばらつきは誤差ではなく, 圧力が異な るためである.)水素化直後の格子定数a(0)が大きくばらつ いているのはT, $p_{\rm H}$ の値によって水素濃度が異なるためであ る. 問題は,長時間経過後の漸近値 $a(\infty)$ がT, $p_{\rm H}$ の値によ らずほぼ同じ値をとり,純Niと同様の僅かな熱膨張を示し ているように見えることである. 全く同様の格子定数変化は fcc の Fe, Co でも観察された. これは熱平衡になるまで空 孔とH原子が導入されると,すべて同じ組成 M_3 VacH₄に 到達するためと考えられる.

実際, Zhang-Alavi による Pd についての第1原理計算で も、L1₂型規則構造をもつ Pd₃VacH₄の格子定数は Pd より 僅かに大きくなっている^(1.63). この組成では水素による格 子膨張と空孔による格子収縮がほぼ打ち消し合っているのだ.

次に M_3 VacH₄ 規則構造(図 1·11)の意味することを考察 しよう.この構造では,空孔は最隣接サイトに常に6個の H原子をもち,一方 H 原子は全体の 3/4 が空孔 2 個に接し ていて,残り 1/4 は空孔に接していない.この構造では, 内部エネルギーが低くなるようにできるだけ多くの Vac-H 対が形成されているのだ.また,空孔同士は最隣接サイトを 占めることなく,常に第 2 隣接サイトを占めている.これ は隣接する空孔間に斥力が働くことを意味している.

理論計算では、H原子と空孔とが相互作用しながら出入 りするとき、ある温度での熱平衡状態でそれぞれ何個ずつ入 るのかを求めようとする.計算はモンテカルロ法(詳しくは メトロポリス重点的サンプリング法)によって行うのだが、 それに先立って、相互作用を記述するモデルを構築しておか なくてはならない.そこで、上に述べた考察から、近接相互 作用については以下のようにする.

- (1) Vac 同士は最隣接サイトを占めることができない.
- (2) H-H 間には近接相互作用は働かない(最隣接サイトも 含めてランダムに占有できる.)
- (3) 最隣接 Vac-H の相互作用は束縛エネルギー-e_b
 (e_b>0)で記述する.

しかし、金属-水素系では長距離に働く弾性相互作用も重要であることが知られているので、これも取り入れなくてはならない.水素の溶解熱 *e*_Hは、格子が膨張しているときにはそれに比例して低下する.これを

$$e_{\rm H} = u_{\rm H} - \alpha_{\rm H} \varDelta \tag{2.1}$$

と表す. $u_{\rm H}$ は完全結晶での溶解熱, Δ は格子膨張, $\alpha_{\rm H}$ は金 属格子の性質によって決まる定数である.同様の弾性相互作 用の表現は空孔についても成り立ち,空孔生成エネルギーは $e_{\rm v} = u_{\rm v} + \alpha_{\rm v} \Delta$ (2·2) と書かれる. $u_{\rm v}$ は完全結晶での生成エネルギー, $\alpha_{\rm v}$ は金属 格子の性質によって決まる定数である.空孔は格子収縮を起

こすので収縮した格子中のほうが生成しやすい(e_vは低下する). これは格子間 H 原子が格子膨張を起こすために膨張した格子中のほうが溶けやすい(e_H が低下する)のと同様である.

格子膨張 Δ は格子間 H 原子による分 $\Delta_{\rm H}$ と空孔による分 $\Delta_{\rm v}$ の和で表され,



図2・2 空孔-水素の束縛エネルギー e_b=0.41 eV,数種 類の水素濃度 x において,導入される空孔濃度 の温度依存性⁽¹⁾.

$(2 \cdot 3)$

$$\Delta_{\rm H} = (\Omega_{\rm H} / \Omega_0) c_{\rm H} \tag{2.4}$$

 $\Delta_{\rm v} = -\left(\Omega_{\rm R}/\Omega_0\right)c_{\rm v} \tag{2.5}$

と書かれる.ここで $c_{\rm H}$, c_v は単位体積当たりの H 濃度と空 孔濃度, $\Omega_{\rm H}$ は格子間 H 原子による体積膨張, $\Omega_{\rm R}$ は空孔の 緩和体積である(式(1·1)参照).

計算は Ni を念頭におき, Vac-H 束縛エネルギー e_b =0.41 eV として行った.図2・2はいくつかの H 濃度について,生 成する空孔濃度を温度の関数として示したものである.以 後,濃度はとり得るサイト数に対する比で表し,H濃度と 空孔濃度を x, x_v と書く.(Fcc 格子では金属原子のサイト数 と H 原子の占める O サイト数は同じ.)まず目につくのは, ある温度で相転移のような現象が起こり,昇温するにつれ, 空孔濃度が比較的高い状態から低い状態に移ることである. (これらを空孔 rich 状態,空孔 poor 状態とよぶ.)空孔 rich 状態での到達空孔濃度は,x = 0.95で $x_v = 0.25$ になってい て,これはほぼ M₃VacH₄組成に相当する.高温側で空孔濃 度の低い状態に移るのは,少ない空孔がランダムに分布した 方がエントロピーの増大によって自由エネルギーが低下する ためであろう.図に見られるのは,主に空孔の濃度と分布の 変化によって引き起こされる相転移と考えられるのだ.

図2・3は Vac-H 束縛エネルギーが $e_b = 0.41 \text{ eV} \ge 0.34 \text{ eV}$ の場合の空孔濃度の比較である. 束縛エネルギーが小さくなると,空孔濃度が低くなるだけでなく秩序配列がしにくくなりランダム相が広い温度範囲で卓越するようになる.

図2・4は e_b =0.41 eV, x=0.5 の場合について,空孔へのH 原子の配位数が温度によってどのように変化するかを示す. 低温相での最隣接H原子数はほぼ6に近いが,高温相では 2,3,4,5,6 個に分かれている.これは高温相がランダム相 であることを示すものである. x=0.5 という低水素濃度で

解 説







図2・4 束縛エネルギー $e_b = 0.41 \text{ eV}$,水素濃度x = 0.5の場合について、空孔に隣接する H 原子数の 温度依存性⁽¹⁾.昇温過程と降温過程の計算で若 干のヒステリシスが見られるが、これが有意の 差であるかどうかは分からない.

も低温での最隣接 H 原子数がほぼ6 であるのは,空孔 rich 相が分離析出していることを示す.この2 相分離は空孔分 布のマップによって確認されている.また,低温領域での2 相分離は H 原子の周りの空孔配位数にも現れていて(図2・ 5),低温での配位数はほぼ2 であるのに,高温相では0 か1 になっている.

以上に述べたことは次のように要約される.(1)金属を水素 と空孔が出入りできる状態に保持すると,それらが多量に導 入され超多量空孔生成が起こり得る.(2)その状態は,空孔が 比較的多い状態(空孔 rich 状態)と比較的少ない状態(空孔



図2・5 束縛エネルギー $e_b = 0.41 \text{ eV}$,水素濃度x = 0.5の場合について,H原子に隣接する空孔数の温 度依存性⁽¹⁾.昇温過程と降温過程の計算で若干 のヒステリシスが見られるが,これが有意の差 であるかどうかは分からない.

poor 状態)に大別される.(3)空孔 rich 状態は Vac-H 結合エ ネルギーが大きい場合に生成される.(4)その場合,温度上昇 に伴い,空孔 rich 相から空孔 poor 相への転移が起こる.(5) 空孔 poor 相での空孔濃度は温度上昇とともに増加する.

空孔 poor 相は純金属を基として、そこに H 原子と空孔が ランダムに導入された状態であり、一方、空孔 rich 相は欠 陥水素化物 M_3 Vac H_4 を基として、その空孔の一部がランダ ムに抜けた(空孔に金属原子がランダムに入った)状態であ る.したがって空孔 rich 相が形成されるには、安定な欠陥 水素化物が存在しなくてはならない.Fcc 金属で空孔 rich 相がよく見られるのは L1₂ 構造の欠陥水素化物 M_3 Vac H_4 が 安定だからであろう.Bcc 構造では B2 型の欠陥水素化物が それほど安定ではなく、hcp 構造では安定な欠陥水素化物が 存在しないらしい.ただし、ここで注意しておきたいのは、 空孔 rich 相ができないときでも、空孔 poor 相での空孔濃度 は純金属中での熱平衡濃度より何桁も高くて、「超多量」空 孔であることに変わりはない、ということである.

図2・6は Vac-H 結合エネルギーが比較的小さい(空孔-水 素クラスターの生成エネルギーが比較的大きい)Pd と Nb に ついて,生成した空孔濃度を水素濃度の関数として示したも のである⁽²⁾. Pd では水素濃度 $x \sim 0.7$ 以上で空孔 rich 相が現 れているが, Nb ではx < 0.5までの範囲で空孔 poor 相のみ が見られている.図1・10に示した α -Fe の場合にも,空孔 poor 相が見られていた.

さて、これまで述べてきたのは金属-水素-空孔3元系で の熱平衡状態についてであったが、この状態が実際に実現す るかどうかは改めて考察しなくてはならないことである.

まず図2・2-2・5に示した温度範囲のうち、実現するのは融



図2·6 Pd-H, Nb-H 系において導入される空孔濃度 x_v の水素濃度依存性⁽²⁾.

点以下に限られる. たとえば Ni では融点は1453℃であるか ら,水素濃度が *x*=0.95では融点以下で常に空孔 rich 相とな り,空孔 poor 相への転移は起こらない.

融点以下の固体状態で熱平衡状態が実現するかどうかは kineticsの問題になる.格子間 H 原子は動きやすいが空孔 は動きにくいので,問題は空孔の動き如何にかかっている. 前章に述べた fcc 金属についての多くの実験が高温で行われ たのは X 線回折用粉末試料(径~10 μ m)中への空孔の導入 に要する時間を数時間程度に抑えるためであった.一方, bcc の Fe(前章1·3) と Nb(次章2·2)では空孔が動きやすいた め,より低温での観測が可能になっている.いずれにせよ, 状態変化は常に熱平衡に向かって起こるものであるから,行 き着く先,到達すべき状態を知っておくことは重要である.

Pd や Fe を水素雰囲気中で塑性変形したときに(前章1・3 および3・2,3・3章)多量の空孔が導入されるのも,力学的な エネルギーが与えられることで熱平衡状態に向かっての変化 が起きるものと理解される.さらに2・3章に述べるめっきの 場合に多くの空孔が導入されるのは,原子が1個ずつ積み 重ねられていく過程で室温での熱平衡構造が形成されたもの である.

このように,従来いろいろな局面で観測された超多量空孔 生成は金属-水素-空孔3元系の統計熱力学によって初めて 統一的に理解されるようになった.これは金属学の新しい展 開と言ってもよいだろう.

2·2 拡散促進効果

水素の固溶に伴って空孔が多量に生成すると、それによって金属原子の拡散も促進されることが期待される.

水素による金属原子拡散の促進を最初に報告したのは 1978年のSidorenkoらの論文だろう⁽³⁾.彼らは数種類のNi 合金での相転移が水素雰囲気中で促進されることを見出して 報告したのだが⁽³⁾⁽⁴⁾,残念ながら,この研究は注目されるこ となく埋もれてしまった.この現象が再発見されたのは,



図2.7 Cu-Ni 拡散対を用いた相互拡散実験⁽⁸⁾. 800℃, 5 GPa に 30 min 保持した後の濃度分布.(上) 水素なし,(下)水素あり.水素による拡散促進 効果が明らかに見られる.

Pd 合金についての Flanagan らの研究がきっかけであった. 彼らは Pd 合金の相分離が水素によって促進されることを見出して,この現象を「水素誘起格子易動」(Hydrogen Induced Lattice Mobility)と名付けたが,その機構は説明できなかった⁽⁵⁾⁻⁽⁷⁾.

それが水素誘起空孔生成によるものであることを示したの は、Pd-Rh 合金についてのわれわれの実験であった^(1.52). Pd-Rh 合金はスピノーダル分解をする系であるが、分解速 度は極めて遅くて、高温から急冷した Pd_{0.8}Rh_{0.2} 合金は 600℃に1年間保持しても相分離しなかったと報告されてい る.ところが、この組成の試料を水素圧5 GPa で徐々に加 熱したところ、550℃、3 min で相分離が観測されたのであ る.反応生成物の電子顕微鏡観察では、Rh-rich の析出相が 平均 0.1 μ m 間隔で分散していた.これが550℃で 3 min の 相互拡散で起こったことから相互拡散係数は通常の条件下に 比べて少なくとも7桁大きくなっていたと見積もられた. 回収試料には Cu₃Au 型の空孔秩序構造(M₃Vac)が形成され ていることも認められた.

われわれは、次に Cu-Ni 拡散対による実験を行った⁽⁸⁾. 径 1 mm,厚さ 0.1 mmの Cu と Niの円板を重ねて高圧セル 中で接合させ、熱処理を施した後に厚さ方向の Cu 濃度分布 を測定したところ、高圧セル中に水素源を仕込んだときと仕 込まないときで、組成分布に大きな違いが見られた.圧力5 GPa,800°C,30 min 保持した場合の結果を図2.7に示す.Ni 中への Cu の拡散が水素圧下で著しく促進されていることが

解 説

わかる.解析の結果,相互拡散係数はNi側で約4桁,Cu 側で約1桁大きくなっていた.水素の効果がNi側で顕著な のは,Cuに比べて溶解度が大きいためである.

こうして相互拡散が水素によって何桁も速くなることがい くつかの2元合金で観測されたのだが、相互拡散係数には 熱力学的因子の組成依存性という問題があるために、観測さ れた拡散促進現象が超多量空孔生成によるものとは断定でき ない.水素による拡散促進機構を明らかにするには、純金属 中の自己拡散への水素の影響を調べなくてはならないのだ.

一般に金属原子の自己拡散係数は空孔濃度と空孔の拡散係 数の積として

$$D = x_{\rm v} D_{\rm v} \tag{2.6}$$

と書かれるが、空孔が空孔-水素クラスターとして存在して いるときには

$$D = x_{\rm cl} D_{\rm cl} \tag{2.7}$$

 $(2 \cdot 8)$

と書かれる.水素の影響は,濃度と拡散係数に対して別々に 調べてやる必要がある.

これは Pd について,高温・高水素圧下での格子収縮を解 析することによって可能となった^(1·51).格子収縮の大きさ から空孔-水素クラスター濃度を,また収縮過程の時定数か らその拡散係数を求めることができたのだ.得られた結果

 $x_{\rm cl} = 1.3 \times 10^3 \,{\rm e}^{-0.72 \,{\rm eV}/kT}, D_{\rm cl} = 4 \times 10^{-8} \,{\rm e}^{-1.2 \,{\rm eV}/kT} \,{\rm m}^2/{\rm s}$

を空孔についての値^(1.57)

 $x_v = (1 \sim 10) e^{-1.7 eV/kT}$, $D_v \sim 10^{-5} e^{-1.03 eV/kT} m^2/s$ (2・9) と比較すると

 $x_{cl}/x_v \sim 10^{2-3} e^{0.98 e^{V/kT}}, D_{cl}/D_v \sim 4 \times 10^{-3} e^{-0.17 e^{V/kT}}$ (2·10) となる. 水素化によって空孔の熱平衡濃度は大きくなるのに 対して, 拡散係数は水素を伴うことで小さくなっている. こ れから, 水素のある場合とない場合の自己拡散係数 (D_m (PdH_x) と D_m (Pd))の比は

 $D_{\rm m}({\rm PdH_x})/D_{\rm m}({\rm Pd}) \sim e^{0.81 \, {\rm eV}/kT}$ (2.11) と得られる.自己拡散係数は水素の存在下で(とくに低温で) 大きくなっており、これは水素による空孔濃度の増大が拡散 係数の低下の効果を上回るためであることが分かる.水素は 空孔に比べて非常に動き易いために、空孔周辺の水素は空孔 の移動に対して大きな障害にはならない.

より詳細な実験は、その後、Nbについて行われた.図2・ 8はNbについてのトレーサー実験の結果⁽⁹⁾である.予め水 素化した試料片に放射性⁹⁵Nbを塗布し、石英カプセルに封 入して熱処理した後に侵入曲線を測定した.図に記入した水 素濃度は高温での解離平衡圧から算出した値である.純Nb のデータと比較すると、水素による拡散促進効果は低温にな るにつれ、また水素濃度が高くなるにつれて顕著になり、 520℃(H/Nb=0.34)では約8桁に達している.

もう一歩踏み込んで,空孔の濃度と拡散係数を別々に決める実験を,単結晶NbH_xの電気抵抗測定によって行った^(1.58). 試料は単結晶Nbを厚さ0.11~0.70 mmの短冊状に切り出して,電解チャージにより室温で水素化する.これを200~300℃に加熱して電気抵抗の経時変化を測定したとこ



図2・8 Nbの自己拡散の水素による促進効果を示すア レニウスプロット.Nb-H 合金については2組 の実験データ(…小池ら⁽¹⁻⁵⁸⁾,●飯田ら⁽⁹⁾)が示 してある.



図2・9 NbH_{0.21}単結晶試料を300℃に保持したときに観 測された電気抵抗の経時変化⁽¹⁻⁵⁸⁾.電気抵抗増 加は試料表面から空孔-水素クラスターが侵入 することによって起こる.抵抗増加には時定数 の短い成分と長い成分がある.

ろ,約50hにわたる抵抗増加が観測された(図2・9).抵抗増 加は時定数の異なる2つの指数関数の和としてほぼ表現さ れ,そのうち遅い過程の時定数(で2)は試料厚さの2乗に比例 することが確認されたので,試料表面から侵入した空孔-水 素クラスターによるものと同定された.これより空孔-水素 クラスターの拡散係数は

 $D_{cl}=3 \times 10^{-7} e^{-0.75 eV/kT} m^2/s$ (2・12) と得られた.空孔の拡散係数と比べると,前指数項は約2 桁小さく,活性化エネルギーは 0.20 eV 大きくなっていて, これらはいずれも空孔移動を妨げる方向に働いている.活性 化エネルギーの増加は水素移動の活性化エネルギー(0.12 eV)と同程度であって,これは空孔移動の際に周囲の水素原



図2·10 300℃で Nb-H 合金中に導入される空孔-水素 クラスター濃度 x_{cl}^(1·58). x_{cl} は水素濃度 x にほ ぼ比例している.

子 1~2 個が同時に移動しなくてはならないためとして直観 的に理解されよう.

一方,速い過程は転位に沿っての高速拡散後に内部に拡散 する過程と推論される.これは単結晶でも全抵抗変化の約 3/4を占めていて,多結晶試料ではほとんど全てが速い過程 によっている.

導入された空孔-水素クラスター濃度は抵抗増分から概算 することができる[†]. 300[°]Cでの空孔-水素クラスター濃度の 水素濃度依存性(図2·10)を見ると,両者はほぼ比例している $(x_{cl}\sim 1.3\times 10^{-2} x)$.また NbH_{0.26} についての温度依存性か ら,熱平衡濃度は

```
x_{cl}=2 \times 10^{\pm 1} e^{-0.3 \pm 0.1 eV/kT} (2·13)
と得られた. この生成エネルギーは純 Nb 中での空孔生成エネルギー(e_{f}^{v}=3.0 eV)に比べると大幅に低下している. この低下が空孔周辺に 6 個の水素原子がトラップされることによって生じたものと仮定すると,平均の束縛エネルギーはe_{b}=0.46 eVとなる.表1·1に示した値(0.55 eV)が若干大きいのは,これが水素原子 1~2 個をトラップした状態について得られた値であることを考えれば自然である.
```

これらの実験結果を合わせると、NbH_{0.26}中でのNb原子の拡散係数は

D=*x*_{cl}*D*_{cl}=6×10^{-7±1}e^{-1.0±0.11}e^{V/kT}m²/s (2·14) と得られる.これを図2·8の右側に点線で記入してある.純 Nbのデータを外挿して比べると,300℃での自己拡散係数 は24桁も大きくなっている!

ところで、ここに述べた水素化された Nb の自己拡散では、 2 つの異なる方法で得られた温度依存性が、一見、つながら ないように見える.(無理につなげようとすればS字型にな



図2·11 Nb-H 合金の Nb 拡散のアレニウスプロットに 見られる S 字型温度依存性の説明⁽⁹⁾. 空孔-水 素クラスターの生成エネルギー $e_{f}^{cl} \approx e_{f}^{v} - re_{b}$ に おいて占有数rが温度に依存することを考慮 した計算(実線)によって、実験値(…, \bullet)を ほぼ説明できる.

る!)これは何を意味するのか,次にその理由を考えよう. 空孔-水素クラスターの生成エネルギー $e_{f}^{cl} = e_{f}^{v} - re_{b}$ は,トラ ップされた水素原子が高温で解放されていくにつれて(rが 小さくなるにつれて)次第に大きくなり,空孔の生成エネル ギー e_{f}^{v} に近づいていく.これに従って,熱平衡濃度はrが 減少する温度領域でいったん減少してから,高温で再び増加 することになる.図2·11はこの簡単なモデルによる拡散係数 の計算を実測と比較したもので,両者はほぼ合っている.こ の拡散係数や空孔-水素クラスター濃度のS字型温度依存性 は水素誘起空孔が示す一般的な性質であると言える.

水素誘起空孔のもつ,この独特な温度依存性のために,ある温度(とくに中間温度領域)での性質を他の温度でのデータから外挿して予測するのは難しい.

2.3 めっきにおける超多量空孔生成

めっき膜が特異な性質を示すことは、Cu めっきについて 古くから知られていた.めっき膜はふつう粒径が数10 nm 程度の細粒組織を持つものであるが、Cu めっき膜では室温 で数日後に急速な粒成長が起き、それに伴って硬度が大幅に 低下することがある.図2・12はその一例である⁽¹⁰⁾.この室 温時効による再結晶は常に起こる訳ではなく、電解液に特定 の添加剤を加えたときに限って顕著に見られる.いずれにせ よ、Cu の再結晶は通常はもっと高温で起こることなので、 これが室温で起こるのは、何らかの理由でめっき膜中に多量 の空孔が導入されたことを示している.

中原らは,原子移動が起こらない温度で作製された膜(蒸 着膜やめっき膜)中には多量の欠陥が存在すると仮定してこ

解 説

[†] ここでは空孔-水素クラスターによる電気抵抗を Nb 中のフレン ケル対についての値 7±1.5 μΩ cm/at%^(1.57)の 1/2 とした. 不 確かさは因子 2 程度であろう.



図2·12 Cu めっき膜の硬度の経時変化の例⁽¹⁰⁾.数日後 に起こった硬度の低下は,結晶粒の粗大化に 対応していた.

の現象を説明しているが⁽¹¹⁾,このような大まかな議論では めっき膜に固有の性質を説明することはできない.

ここでは、電解めっき膜が多量の空孔-水素クラスターを 含むものであることを示すことで、この性質を理解しようと する.一般に電解めっきでは、液中の金属イオンが還元・析 出するときに、水素イオンもいくらかは還元されてめっき膜 中に固溶する.水素が固溶した状態の安定構造は空孔を含む 欠陥構造であるから、めっき膜では金属原子と水素原子と空 孔とが積み上げられていって、室温での安定構造が作られる に違いない.めっき膜中には空孔-水素クラスターが超多量 に存在すると予測されるのである.この予測に基づいて電解 Niの水素熱放出スペクトルを測定してみたところ、放出ピ ークの温度は高温・高水素圧処理試料に見られたもの(図1・ 9)とピタリと一致していて、試料中に濃度10⁻⁴程度の空孔-水素クラスターが存在することを示していた⁽¹⁻⁵⁴⁾.

Cu めっき膜の室温再結晶が添加剤の種類によるのは,空 孔-水素クラスターの生成が添加剤の種類に依存するためで あることが,最近行われた熱放出スペクトル測定によって明 らかにされた⁽¹²⁾.これは空孔型の点欠陥が特定の添加剤に よって導入されるという陽電子消滅実験の結果⁽¹³⁾と合って いる.Cu については,LSI 配線の際に,蒸着膜上にめっき 膜を被覆すると膜全体が柔らかく変形し易くなるという興味 深い観察がされていたが⁽¹⁴⁾,これもめっき膜中の空孔-水素 クラスターが蒸着膜中に移動するためにクリープが起こり易 くなったものとして理解される.

一般に,めっき膜中は超多量空孔を含むために,ふつうは 高温でしか起こらない現象が比較的低温で起こるのである.

Fe-Ni 合金は磁性材料として広く使われているが,そのめ っき膜をトルクセンサーとして使おうとする試みには,磁性 が室温で経時変化することが障害になっていた.経時変化の 原因は長いこと不明だったのだが,これがめっき膜に固有の 現象であることから水素の状態変化が関与しているのではな いかと考えて,熱放出スペクトルを測ってみたところ,めっ き後の時間経過につれてスペクトルの形状が大きく変化する



図2・13 Ni₆₄Fe₃₆ 合金めっき膜の水素熱放出スペクト ル^(1・53).めっき後の時間経過により、水素は 徐々に失われていく.(スペクトルは1目盛ず つずらしてある.)



 図2・14 Ni₆₄Fe₃₆ 合金めっき膜の水素熱放出スペクト ル⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾. (a)めっき膜に395℃パルス加熱を 施したもの,180℃,1h焼鈍を加えたもの, 180℃,2.5h焼鈍を加えたもの. (b)パルス加 熱と2.5h焼鈍を施した試料を110℃,400h 時効した後に放出スペクトルを再測定したも の.この熱処理によって水素の状態は安定化 され,時効による変化は認められなくなった.

ことが見出された(図2·13)^(1·53). そこで,室温付近で状態 変化する水素を取り除くために395℃にパルス加熱後, 180℃,2.5hの焼鈍という熱処理を行ってやることにした. この熱処理後の熱放出スペクトルを図2·14(a)に示す.スペ クトルの形状は,その後に110℃,400hの時効を行っても 変化せず,磁性の変化も全く認められなくなった (図2・14(b))⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾. これは室温で約10年間は磁性が変化し なくなったことを意味する. こうして Fe-Ni 合金めっき膜 を用いたトルクセンサーは,ようやく実用化の目途が立った のである.

(次号へつづく)

文 献

- (1) Y. Fukai, H. Sugimoto: J. Phys.: Condens. Matter, **19**(2007), 436201.
- (2) S. Harada, S. Yokota, Y. Ishii, Y. Shizuku, M. Kanazawa, Y. Fukai: J. Alloys Compd., 404–406 (2005), 247–251.
- (3) V. M. Sidorenko, V. V. Fedorov, L. V. Barabash, V. I. Pokhmurskii: Mataterials Science, **13**(1977), 607–610; Fiz.–Khim. Mekh. Mater., **13**(1976), 27–30.
- (4) V. I. Pokhmurskii, V. V. Fedorov: Materials Science, 17 (1981), 1–8; Fiz.-Khim. Mekh. Mater., 17 (1981), 3–11.
- (5) H. Noh, T. B. Flanagan, B. Corundero, A. Craft: Scripta Metal., 25(1991), 225.
- (6) H. Noh, T. B. Flanagan, M. H. Rasnik: Scripta Metal., 26 (1992), 353–356.
- (7) T. B. Flanagan, H. Noh: J. Alloys Compd., 231 (1995), 1.
- (8) E. Hayashi, Y. Kurokawa, Y. Fukai: Phys. Rev. Lett., 80 (1998), 5588–5591.
- (9) T. Iida, Y. Yamazaki, T. Kobayashi, Y. Iijima, Y. Fukai: Acta

Mater., 53 (2005), 3083-3089.

- (10) 縄舟秀美,福田順成,水本省三,芳賀正記:表面技術,46 (1995),834-839.
- (11) S. Nakahara, S. Ahmed, D. N. Buckley: Electrochem. Solid-State Lett., 10(2007), D17–D21.
- (12) N. Fukumuro, T. Adachi, S. Yae, H. Matsuda, Y. Fukai: Trans. Inst. Metal Finish., 89 (2011), 198–201.
- (13) 宍戸逸朗,松尾明彦,豊山裕万,水野正隆,荒木秀樹,白井 泰治:日本金属学会誌,70(2006),118-121.
- (14) F. Fujikawa, T. Yoshikawa, T. Ohnishi, T. Sato: Jpn. J. Appl. Phys., 40(2001), 2191–2196.
- (15)向坊長嗣,清水康夫,深井 有,廣井俊顕:日本金属学会誌, 71(2007),809-814.
- (16) N. Mukaibo, Y. Shimizu, Y. Fukai, T. Hiroi: Mater. Trans., 49 (2008), 2815–2822.



深井

- 1903年より 中天人子理上子部初理子科専田講師 助教授,教授をへて

2005年 定年退職,名誉教授となる

その間,イリノイ大学(米),グルノーブル大学,エコ ールポリテクニク(仏),ローマ大学(伊)ほか,国内の 多くの大学・研究所の客員を勤めた.

有 専門分野:金属-水素系の物性,格子欠陥,拡散,高 圧物性,地球科学

◎現在も高エネルギー加速器研究機構・物質構造研究所,東大生産技術研究 所,兵庫県立大学等と研究協力を行っている.最近,「気候変動とエネルギ ー問題−CO₂温暖化論争を超えて」(中公新書)を著した.
